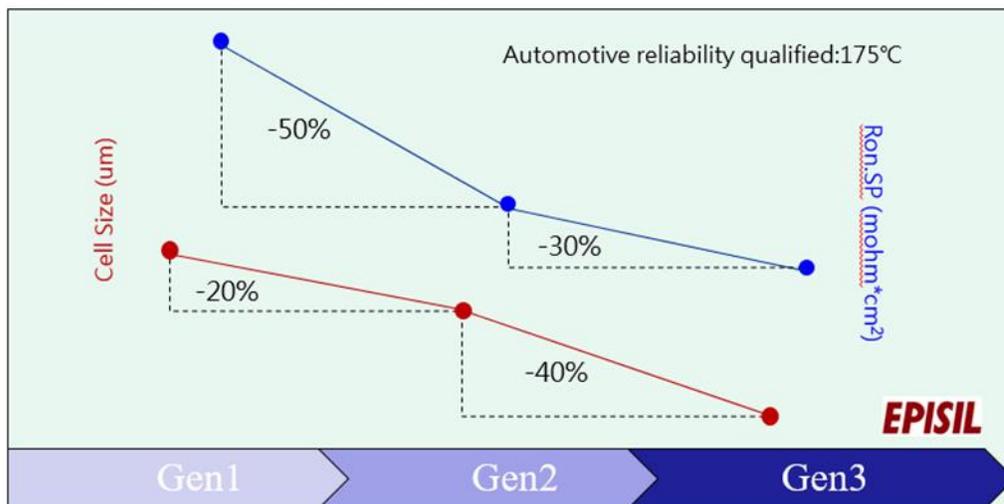


## 漢磊科技 推出碳化矽第三代平面型MOSFET技術平台，有利於接單及國際客戶合作

漢磊科技宣布，推出碳化矽第三代平面型MOSFET G3方案，此新技術平台已通過國際客戶的可靠度測試，客戶端的1200V產品並通過車用規範1320V/175C junction temperature over stress，將晶片尺寸縮小與降低Rdson，使客戶能夠有效率地整合元件與效能，提供給客戶更小更低能耗更高功率密度的產品，以滿足市場技術最新發展的需求，同時該技術已與國際IDM大廠能力並進。

漢磊科技的研發團隊持續投入新一代製程技術，目前正式對客戶開放碳化矽第三代平面型MOSFET技術平台，相較前一代G2平台，第三代G3降低了元件面積約40%並改善導通電阻(Ronsp)30%，滿足客戶對技術提昇與更有效率的需求，並增加更多國際IDM客戶合作的商機。



漢磊科技深耕化合物半導體技術及量產已長達10年，碳化矽的產品技術可應用在最先進太陽能逆變器、儲能系統、尖端EV車用模組及進一步支援AI高效能算力伺服器等等。藉由新一代技術平台的推出，提供客戶更有競爭力的產品，漢磊在碳化矽技術應用成長的道路上，提供超越業界的服務內容。與此同時將持續開發下一世代的產品技術，以更頂尖的電源設計滿足客戶與市場需求，期許成為專注化合物半導體代工業界的領導者。